

การเตรียมและศึกษาดักษณะเฉพาะของพิล์มนบัง โครเมี่ยม ในไตรค์
ที่เคลื่อนด้วยเทคนิค รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตอรอน สปีตเตอริง

กรรมการ วรรณทวี



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ บรรณทิว ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศิing ไชยคุณ) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
(ดร.วิเชียร ศิริพร) ประธาน

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศิing ไชยคุณ) กรรมการ

.....
(ดร.อรรถพล เชียสุกเกดุ) กรรมการ

.....
(ดร.น้ำพนธุ์ ศรีสุข) กรรมการ

คณะกรรมการต้อนรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวดี ดันติวนารักษ์) คอมบดีคณะกรรมการ
วันที่.....๒๓.....เดือน.....มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๕๔

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ประกาศคุณภาพ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศิริ ไชยคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบคุณ ดร.วิเชียร ศิริพรม ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ ขอขอบคุณ ดร.อรรถพล เซยศุภเกตุ ที่ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบ และดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข ตัวแทนฝ่ายวิจัยและบุณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก ทราบชัดเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้ โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุน สนับสนุนหลักจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาการและ พลังงาน (VTTF) และห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสม่าสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว (PSS) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทำวิจัยด้วยดี นายอดิศร บูรณวงศ์ ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างในวิทยานิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ พ่อแม่ ที่เคยให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ กับเข้ามาเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทำให้การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดี

กรณิการ์ วรรณทวี

52910040: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ: ฟิล์มบาง/ โครเมี่ยม/ ไนโตรค์/ รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง

กรรมการ วรรณทวี: การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง โครเมี่ยมในไนโตรค์
ที่เคลือบด้วยเทคนิค รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง (PREPARATION AND
CHARACTERIZATION OF CrN THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC
MAGNETRON SPUTTERING) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: สรุรสิงห์ ใชยกุณ, Ph.D.

124 หน้า. ปี พ.ศ. 2554.

ฟิล์มบาง โครเมี่ยม ในไนโตรค์ (CrN) ถูกเคลือบนกรอบอลูมิเนียม และแผ่นซิลิโคน ด้วยวิธี
รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง ผลของเงื่อนไขการเคลือบได้แก่ ความดันย่ออย่างไร
ในโตรเจน ความหนา และกำลังไฟฟ้าของโครเมี่ยมในไนโตรค์ ได้ถูกศึกษา ทั้งนี้สมบัติของฟิล์มบาง
โครเมี่ยมในไนโตรค์ที่เคลือบได้ เช่น โครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิว ความหนา และองค์ประกอบของ
ชาตุทางเคมี ถูกตรวจสอบด้วย X-ray diffraction (XRD) atomic force microscopy (AFM) และ¹
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าสามารถเคลือบฟิล์ม
โครเมี่ยมในไนโตรค์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบคิวบิกบันวัสดุรองรับได้ โดยความดันย่ออย่างไร ในโตรเจน
และกำลังไฟฟ้ามีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม ขณะที่ความหนาไม่มีผลต่อ²
โครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม

52910040: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: THIN FILM/ CHROMIUM NITRIDE / REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING

KANNIKA WANTAVEE: PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CrN THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING, ADVISORY COMMITTEE: SURASINGH CHAIYACOUN, Ph. D. 124 P. 2011.

Chromium nitride (CrN) thin films were deposited on glass slides and silicon wafers by reactive DC magnetron sputtering method. The effects of deposition parameter such as N₂ partial pressure, thickness and power have been investigated. The properties of the as-deposited CrN thin film such as crystal structure, surface morphology, thickness and transmittance were characterized by X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX), respectively. The results showed that CrN thin films with monoclinic phase were successfully deposited on substrates. The N₂ partial pressure and power were effect on the crystal structure and surface morphology of films, whereas thickness was not effected on the crystal structure and surface morphology of films.

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
สารบัญ.....	๗
สารบัญตาราง	๘
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1 บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	๓
ขอบเขตของการวิจัย	๓
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๔
กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง	๔
การก่อเกิดฟิล์มบาง	๕
โครงสร้างของฟิล์มบาง	๗
การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปีตเตอริง	๙
กระบวนการ โกรต์วิดิษาร์จ	๑๖
ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปีตเตอริง	๒๑
ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง	๒๓
ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปีตเตอริง	๒๗
การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธี รีแอคติฟ สปีตเตอริง	๓๐
ฟิล์ม โกรเมี่ยม ในไตรด์.....	๔๔
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๕๐

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 วิธีดำเนินการวิจัย	55
กรอบแนวคิดของงานวิจัย.....	55
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	57
เครื่องเคลื่อนพื้นบังระบบเรแอคเตฟ คิซี สปิตเตอร์ริง	60
การสร้างสภาพสุญญาณ.....	61
การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลื่อนพื้นบัง.....	63
การเคลื่อนพื้นบัง โครเมียม ในไตรค์.....	64
การหาลักษณะเฉพาะของพื้นบัง โครเมียม ในไตรค์	65
แนวทางการทดลอง	67
1. การศึกษาผลของความดันย่อข้อเก๊สในไตรเจน.....	67
2. การศึกษาผลของความหนาของพื้นบัง	68
3. การศึกษาผลของกำลังไฟฟ้าในกระบวนการเคลื่อนบ.....	69
4 ผลการวิจัย.....	70
ผลของความดันย่อข้อเก๊สในไตรเจน	70
ผลของความหนา	77
ผลของกำลังไฟฟ้า	84
5 อภิปรายและสรุปผล	91
อภิปราย	91
สรุปผล.....	97

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บรรณานุกรม.....	98
ภาคผนวก.....	102
ภาคผนวก ก องค์ประกอบของชาตุทางเคมีของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ (Lattice constants) และ ^ก ขนาดผลึก (Crystallite size).....	103
ภาคผนวก ข ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่.....	114
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	124

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 พลังงานจีดเริมของเป้าสารเคลื่อนชนิดต่าง ๆ	13
2-2 ระบบผลึกของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์	44
2-3 ข้อมูลการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของผลึก โครเมียม ในไตรค์เฟสออร์โทรอมบิก	43
2-4 ข้อมูลการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของผลึก โครเมียม ในไตรค์เฟสคลิริก	48
3-1 เงื่อนไขการเคลื่อนพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจนต่าง ๆ	67
3-2 เงื่อนไขการเคลื่อนพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลื่อนด้วยเวลาต่าง ๆ	68
3-3 เงื่อนไขการเคลื่อนพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	69
4-1 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจนต่าง ๆ	72
4-2 ขนาดผลึกของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจนต่าง ๆ	72
4-3 ความหนาและความหนาผิวของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจนต่าง ๆ	75
4-4 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลื่อนด้วยเวลาต่าง ๆ	79
4-5 ขนาดผลึกของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลื่อนด้วยเวลาต่าง ๆ	79
4-6 ความหนาและความหนาผิวของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยเวลาต่าง ๆ	82
4-7 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	86
4-8 ขนาดผลึกของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	86
4-9 ความหนาและความหนาผิวของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	88
ก-1 รูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์	110

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 การก่อเกิดฟิล์มบาง.....	6
2-2 โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ.....	8
2-3 อันตราริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิวสัมผัสดู.....	10
2-4 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง.....	11
2-5 ข้อดีของทองแดงที่ถูกชนด้วยไอออนจากแก๊สสารก่อนที่พลังงานต่าง ๆ.....	13
2-6 การเปลี่ยนแปลงค่าอิลค์ของเป้าทองแดง (Cu) , เงิน (Ag) และเทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ไอออนพลังงาน 45 keV จากธาตุที่มีเลขอะตอมค่าต่าง ๆ	15
2-7 การเปลี่ยนแปลงของข้อดีเมื่อใช้ไอออนของprototh พลังงาน 200 eV ชนเปานิกเกล (Ni), โมลิบดินัม (Mo) , ทังสเทน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุ่งการตอกกระหบค่าต่าง ๆ (วัดเทียบกับแนวโน้มตั้งฉากบนเป้า)	15
2-8 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าระหว่างข้ออ้างอิงต่อ ของกระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดิษชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจุแก๊สนีโอน	17
2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทะลุและผลคูณระหว่างความดัน (P) และระยะระหว่างอิเล็กโทรด (d)	18
2-10 โกลว์ดิษชาร์จของหลอดคันนอนยาว 50 cm ที่ความดัน 1.33 mbar	19
2-11 ระบบสปัตเตอร์ริงแบบ ดีซี สปัตเตอร์ริง	21
2-12 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่าอิลค์และกระแสไฟฟ้าใน ระบบสปัตเตอร์ริงของนิกเกลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างข้ออ้างอิงต่อ ที่วางห่างกัน 4.5 cm	22
2-13 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก.....	23
2-14 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่าง ๆ โดยที่ a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียวส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ	25
2-15 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบในระบบพลาวร์ แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง.....	26
2-16 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันนาลันซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง.....	28
2-17 ลักษณะพลาสม่าของระบบสปัตเตอร์ริง	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-18 การเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเป็นสารประกอบระหว่างแก๊สไวน้ำปฏิกิริยากับอะตอม เป้าสารเคลื่อนในบริเวณต่าง ๆ	30
2-19 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม	33
2-20 ความเข้มของพื้นที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในตำแหน่งที่มีการสะท้อนรังสี.....	35
2-21 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Scanning Probe Microscope	36
2-22 ลักษณะของแรงกระทำระหว่างอะตอมที่เกิดขึ้นในระบบหางระหว่างวัตถุต่างๆ	37
2-23 เครื่อง AFM แบบ Multimode.....	38
2-24 ลักษณะการสั่นของคานที่มีเงินติด	39
2-25 การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์เพลฟะตัวโดยใช้สำอาอิเล็กตรอน	41
2-26 การเกิดรังสีเอกซ์เพลฟะตัวที่ระดับพลังงานของชั้นโตกต่าง ๆ	42
2-27 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDX).....	42
2-28 ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบของชาตุทางเคมีด้วยเทคนิค EDX.....	43
2-29 เพศของโครงเมี่ยมในไตรค์.....	44
3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย	56
3-2 เครื่องเคลื่อนสัญญาศาสตร์แบบรีแอคติฟ ดีซี แมกนีตอรอน สปีดเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัย	58
3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD)	58
3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM).....	59
3-5 เครื่อง Scanning Electron Microscopy (SEM).....	59
3-6 ไดอะแกรมของเครื่องเคลื่อน	60
3-7 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสัญญาศาส ของระบบเคลื่อนสปีดเตอริง	62
3-8 การถ้างวัสดุรองรับ	63
3-9 การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครงเมี่ยมในไตรค์	66
4-1 รูปแบบการถ่ายแบบรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครงเมี่ยมในไตรค์ เมื่อเคลื่อนด้วยความดันย่อยแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	71
4-2 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางโครงเมี่ยมในไตรค์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM เมื่อเคลื่อนด้วยความดันย่อยแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	73

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 ความหนาและความหมายผิวของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยความดันย่อยแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ	75
4-4 อัตราส่วน Cr : N ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยความดันย่อยแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ	76
4-5 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ	78
4-6 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ	80
4-7 ความหนาและความหมายผิวของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ	82
4-8 อัตราส่วน Cr : N ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ	83
4-9 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	85
4-10 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	87
4-11 ความหนาและความหมายผิวของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	89
4-12 อัตราส่วน Cr : N ของฟิล์มบางโครเมี่ยนในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	90
ก-1 องค์ประกอบของชาตุทางเคมีที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX ของ ฟิล์มโครเมี่ยนในไตรค์เมื่อเคลือบด้วยความดันย่อยแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ	104
ก-2 องค์ประกอบของชาตุทางเคมีที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX ของ ฟิล์มโครเมี่ยนในไตรค์เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ	105
ก-3 องค์ประกอบของชาตุทางเคมีที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX ของ ฟิล์มโครเมี่ยนในไตรค์เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่างๆ	106

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ก-4 แกนสมมุติและมุมขึ้นภายในรูปผลึก.....	107
ก-5 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม.....	109
ก-6 รูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางโครเมียมในไตรค์.....	110
ก-7 Effect of crystallite size on diffraction curves (schematic)	112
ก-8 การหาความกว้างครึ่งหนึ่งของพีกที่มีค่าความเข้มสูงสุด.....	113